

M램, 일본·미국 공동개발 주목

Micron과 Tokyo Electron 중심 20여개 참여 ... 2016년 완료

일본이 M램 개발에 시동을 걸고 있다.

미국 Micron Technology와 Tokyo Electron 등 미국·일본 20여개 반도체 소재기업은 스마트폰 등 모바일 기기 성능을 대폭 향상시키는 차세대 메모리인 M램 양산기술을 공동개발한다고 밝혔다.

M램은 현행 메모리에 비해 기억용량이 10배 많아지고 전자기기 소비전력을 2/3으로 줄인 자기기록식 메모리로 2016년까지 기술 개발을 완료할 계획이다.

Micron Technology는 2018년 상업화를 목표로 개발하고 있다.

M램은 일본 Toshiba가 SK하이닉스와 공동개발하고 있으며 삼성전자도 연구하고 있는 것으로 알려졌다.

일본은 국제경쟁력이 높은 일본의 반도체 소재·장치기업들이 결집해 차세대 메모리 개발의 주도권을 잡을 것으로 기대하고 있다.

일본 반도체 생산설비 공급기업으로 세계 3위인 Tokyo Electron, 반도체 웨이퍼 1위인 Shin-Etsu 등이 참여해 2014년 초부터 개발에 본격 착수한다.

M램은 전원을 꺼도 데이터가 지워지지 않고 컴퓨터, 스마트폰에 쓰이는 D램에 비해 기억용량 등이 향상돼 속도가 빨라지며 한 번 충전으로 스마트폰 사용시간이 기존보다 최대 10배로 늘어날 것으로 기대되고 있다.

<저작권자 연합뉴스 - 무단전재·재배포 금지>

<화학저널 2013/11/25>